Practitioner's Docket No.: 008312-0306031

PATENT

Client Reference No.: T4KM-03S0447

### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: TOORU SUGIYAMA, Confirmation No: UNKNOWN

et al.

Application No.:

Group No.:

Filed: September 22, 2003

Examiner: UNKNOWN

For: SEMICONDUCTOR LASER APPARATUS, SEMICONDUCTOR LASER

CONTROL METHOD, AND IMAGE DISPLAYING APPARATUS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

#### SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Attached please find the certified copy of the foreign application from which priority is claimed for this case:

Country

**Application Number** 

Filing Date

Japan

2002-347506

11/29/2002

Date: September 22, 2003

PILLSBURY WINTHROP LLP

P.O. Box 10500 McLean, VA 22102

Telephone: (703) 905-2000 Facsimile: (703) 905-2500 Customer Number: 00909 Glenn J. Perry / Registration No. 28458

30402720v1

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年11月29日

出願番号

Application Number:

特願2002-347506

[ ST.10/C ]:

[JP2002-347506]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社東芝

2003年 4月 4日

特許儿 · 官 Commissic Japan Patent Lifice



#### 特2002-347506

【書類名】

特許願

【整理番号】

A000205187

【提出日】

平成14年11月29日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02B 6/00

【発明の名称】

半導体レーザ装置、半導体レーザの制御方法、映像表示

装置

【請求項の数】

13

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2 株式会社東芝深谷

映像工場内

【氏名】

杉山 徹

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2 株式会社東芝深谷

映像工場内

【氏名】

土田 雅基

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2 株式会社東芝深谷

映像工場内

【氏名】

加治 伸暁

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2 株式会社東芝深谷

映像工場内

【氏名】

川井 清幸

【特許出願人】

【識別番号】

000003078

【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】

100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体レーザ装置、半導体レーザの制御方法、映像表示装置

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザと、

この半導体レーザから出射される光を平行光に変換する光学手段と、

この光学手段を通過した光を入射する入射端面を有し、途中の所定位置から前 記入射端面に向けて、断面積を一定としたままで前記入射端面におけるコア形状 が楕円形となるように連続的に変化させた第1の光ファイバとを具備してなるこ とを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項2】 前記第1の光ファイバは、途中の所定位置から前記入射端面に向けて、径方向に順次深くなるように潰されていることを特徴とする請求項1 記載の半導体レーザ装置。

【請求項3】 前記光学手段は、前記半導体レーザの出射領域と、前記第1の光ファイバの入射端面におけるコア形状とを共役関係とするように設定されることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ装置。

【請求項4】 前記半導体レーザの出射領域のスロー軸方向の長さをDslow \_\_LD、ファスト軸方向の長さをDfast\_\_LDとし、前記半導体レーザの出射光の広がり角を、スロー軸方向で $\theta$  slow\_\_LD、ファスト軸方向で $\theta$  fast\_\_LDとしたとき

前記第1の光ファイバは、その入射端面における長軸/短軸比を、

Dslow\_LD・sin (θ slow\_LD) / Dfast\_LD・sin (θ fast\_LD) に設定されることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ装置。

【請求項5】 前記第1の光ファイバを通過して出射される光を、コア内に レーザ活性物質を添加した第2の光ファイバに入射させることを特徴とする請求 項1記載の半導体レーザ装置。

【請求項6】 前記第1の光ファイバと前記第2の光ファイバとのコア径が 異なる場合、前記第1の光ファイバを通過して出射される光を、前記第2の光ファイバのコア径に対応するように変換する変換手段を備えることを特徴とする請 求項5記載の半導体レーザ装置。

【請求項7】 複数の半導体レーザと、

この複数の半導体レーザから出射される光が一端部にそれぞれ入射され、他端 部が束ねられた複数の第1の光ファイバと、

この複数の第1の光ファイバの束ねられた他端部から出射される光がまとめて 入射される第2の光ファイバとを具備し、

前記複数の第1の光ファイバの束ねられた他端部のコア断面形状を、前記第2の光ファイバのコア断面形状に対応させるようにしたことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項8】 前記複数の第1の光ファイバの束ねられた他端部と前記第2の光ファイバとのコア径が異なる場合、前記複数の第1の光ファイバの束ねられた他端部から出射される光を、前記第2の光ファイバのコア径に対応するように変換する変換手段を備えることを特徴とする請求項7記載の半導体レーザ装置。

【請求項9】 半導体レーザから出射される光を平行光に変換する工程と、変換された光を、途中の所定位置から入射端面に向けて、断面積を一定としたままで前記入射端面におけるコア形状が楕円形となるように連続的に変化させた第1の光ファイバに入射させる工程とを具備してなることを特徴とする半導体レーザの制御方法。

【請求項10】 前記第1の光ファイバを通過して出射される光を、コア内にレーザ活性物質を添加した第2の光ファイバに入射させる工程を備えることを特徴とする請求項9記載の半導体レーザの制御方法。

【請求項11】 前記第1の光ファイバと前記第2の光ファイバとのコア径が異なる場合、前記第1の光ファイバを通過して出射される光を、前記第2の光ファイバのコア径に対応するように変換する工程を備えることを特徴とする請求項10記載の半導体レーザの制御方法。

【請求項12】 半導体レーザから出射される光を平行光に変換する光学手段と、この光学手段を通過した光を入射する入射端面を有し、途中の所定位置から前記入射端面に向けて、断面積を一定としたままで前記入射端面におけるコア形状が楕円形となるように連続的に変化させた第1の光ファイバとを備える半導

体レーザ装置と、

この半導体レーザ装置の第1の光ファイバから出射される光を励起する第2の 光ファイバと、

この第2の光ファイバによって励起された光を、映像信号に基づいて空間変調する変調手段と、

この変調手段から得られる光出力をスクリーンに投射して表示させる表示手段 とを具備してなることを特徴とする映像表示装置。

【請求項13】 複数の半導体レーザから出射される光が一端部にそれぞれ入射され、他端部が束ねられた複数の第1の光ファイバと、この複数の第1の光ファイバの束ねられた他端部から出射される光がまとめて入射される第2の光ファイバとを備え、前記複数の第1の光ファイバの束ねられた他端部のコア断面形状を、前記第2の光ファイバのコア断面形状に対応させるようにした半導体レーザ装置と、

この半導体レーザ装置の第2の光ファイバから出射される光を、映像信号に基 づいて空間変調する変調手段と、

この変調手段から得られる光出力をスクリーンに投射して表示させる表示手段とを具備してなることを特徴とする映像表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

# 【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体レーザから出射する光を高効率及び高光密度で光ファイバに結合する半導体レーザ装置、半導体レーザの制御方法に関する。また、この発明は、上記の半導体レーザ装置を光源として使用した投射型の映像表示装置に関する。

[0002]

### 【従来の技術】

周知のように、近年では、例えば液晶プロジェクタ等のような投射型の映像表示装置における光源として、半導体レーザを使用するための開発が盛んに行なわれている。

[0003]

この種の映像表示装置にあっては、数W~10Wもの強い光出力を発生する半 導体レーザからの出射光を、ファイバレーザを構成する光ファイバに入射させる ことにより、高い光密度の可視光を生成して映像表示に利用している。

[0004]

ところで、半導体レーザは、一般に髙出力になるとマルチモードになり、その 出射領域が細長い形状となる。例えば、1Wを出力する半導体レーザの出射領域 は、スロー軸方向が100μm、ファスト軸方向が1μmとなっている。

[0005]

また、このような半導体レーザから出射される光は、出射領域面に垂直な光軸に対して、例えば、スロー軸方向に±4°、ファスト軸方向に±20°の広がり角を持って放出される。

[0006]

ここで、半導体レーザからの出射光が入射される光ファイバの受光角は、光軸 対称となっており、例えば、スロー軸方向とファスト軸方向とが共に同じ20° になっているとする。

[0007]

そして、半導体レーザからの出射光を、レンズを介して光ファイバの受光角に合わせた場合、そのビーム径は正弦条件(ビーム径Dと広がり角 $\theta$ との関係、Dsin $\theta$ =一定)にしたがうため、スロー軸方向で $40\mu$ m、ファスト軸方向で $2\mu$ mとなり、ビーム径も細長い形状となる。

[0008]

光ファイバのコア断面形状は一般に円形なので、このような細長い形状のビーム径を有する光を、全て光ファイバに入射するためには、40μmのコア径が必要となる。

[0009]

これにより、半導体レーザから出射する光を、全て光ファイバに入射することが可能となるが、ファスト軸方向にかなりの余裕をもって入射しているために、 入射した光の光密度(入射光パワー/光ファイバコア断面積)は低下する。つま り、光密度が高い状態で光を入射するには、光ファイバのコア断面形状がビーム 径と一致していることが望ましいことになる。

[0010]

特許文献1として提示する米国特許第5677920号明細書には、光ファイバレーザに使用するダブルクラッドファイバにおいて、励起光を入力する内側クラッドの断面形状を長方形にした例が開示されている。

[0011]

しかしながら、コア断面が長方形の光ファイバは、製造が非常に困難であると ともに、長方形断面の光ファイバに通常の円形断面の光ファイバを容易に接続す ることができないという問題が生じている。

[0012]

また、この特許文献1には、複数の光ファイバの出力を合成して、別の光ファイバに光接続することを考慮して、断面が長方形の複数の光ファイバを重ねて、別の光ファイバに光接続する例も開示されている。

[0013]

ところが、光ファイバを重ねる際に高度な位置合わせが必要になるとともに、 接続先の光ファイバの形状に合わせて長方形形状を設計する必要があり、実用的 な構成とは言えないものである。

[0014]

【特許文献1】

米国特許第5677920号明細書

[0015]

【発明が解決しようとする課題】

以上のように、従来は、コア断面形状が円形の光ファイバを用いた場合には、 マルチモードの半導体レーザから出射した光を高効率及び高光密度で光ファイバ に入射させることが困難である。

[0016]

また、コア断面形状が長方形の光ファイバを用いた場合には、製造が困難であるとともに、通常の円形断面の光ファイバと容易に接続することができないとい

う問題が生じる。

[0017]

さらに、コア断面形状が長方形の光ファイバを複数本合成し、別の光ファイバ に光接続する場合には、接続先の光ファイバに合わせて断面形状を設計する必要 があり、実用に不向きとなる。

[0018]

そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、簡易な構成で半導体 レーザからの出射光を高効率及び高光密度で光ファイバに容易に入射させること を可能とした半導体レーザ装置、半導体レーザの制御方法を提供することを目的 とする。また、この発明は、上記した半導体レーザ装置を用いた映像表示装置を 提供することを目的とする。

[0019]

【課題を解決するための手段】

この発明に係る半導体レーザ装置は、半導体レーザと、この半導体レーザから 出射される光を平行光に変換する光学手段と、この光学手段を通過した光を入射 する入射端面を有し、途中の所定位置から入射端面に向けて、断面積を一定とし たままで入射端面におけるコア形状が楕円形となるように連続的に変化させた第 1の光ファイバとを備えるようにしたものである。

[0020]

また、この発明に係る半導体レーザの制御方法は、半導体レーザから出射される光を平行光に変換する工程と、変換された光を、途中の所定位置から入射端面に向けて、断面積を一定としたままで入射端面におけるコア形状が楕円形となるように連続的に変化させた第1の光ファイバに入射させる工程とを備えるようにしたものである。

[0021]

さらに、この発明に係る映像表示装置は、半導体レーザから出射される光を平 行光に変換する光学手段と、この光学手段を通過した光を入射する入射端面を有 し、途中の所定位置から入射端面に向けて、断面積を一定としたままで入射端面 におけるコア形状が楕円形となるように連続的に変化させた第1の光ファイバと を備える半導体レーザ装置と、

この半導体レーザ装置の第1の光ファイバから出射される光を励起する第2の 光ファイバと、

この第2の光ファイバによって励起された光を、映像信号に基づいて空間変調 する変調手段と、

この変調手段から得られる光出力をスクリーンに投射して表示させる表示手段とを備えるようにしたものである。

[0022]

上記のような構成及び方法によれば、半導体レーザから出射される光を、途中の所定位置から入射端面に向けて、断面積を一定としたままで入射端面におけるコア形状が楕円形となるように連続的に変化させた第1の光ファイバに入射させるようにしたので、簡易な構成で半導体レーザからの出射光を高効率及び高光密度で光ファイバに容易に入射させることが可能となる。これにより、高効率な光源を実現することができることから、映像表示装置の低消費電力化、製造コストの低下を実現することが可能となる。

[0023]

#### 【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。図1は、第1の実施の形態で説明する半導体レーザ装置の概略を示している。図1において、符号11は半導体レーザで、その端面に細長い形状の出射領域12が形成されている。

[0024]

この半導体レーザ11の出射領域12から出射される光は、シリンドリカルレンズ13によりファスト軸方向にコリメートされ、シリンドリカルレンズ14によりスロー軸方向にコリメートされて、光ファイバ15に入射される。

[0025]

この光ファイバ15の入射端面部16は、その途中の所定位置から端面に向けて、径方向に順次深く潰していくことにより、断面積を一定としたままコア断面形状が楕円形となるように連続的にテーパ状に変化させて形成されている。

[0026]

例えば、入射端面部 160 コア断面形状が  $20 \times 5 \mu$  mである場合、テーパ長は 10 mmであり、入射端面部 160 コア断面形状が  $40 \times 10 \mu$  mである場合、テーパ長は 20 mmとなる。

[0027]

そして、シリンドリカルレンズ13,14は、半導体レーザ11の出射領域1 2と、光ファイバ15の入射端面部16のコア断面形状とが共役関係となるよう に設計する。

[0028]

ここで、入射端面部 1 6 のコア断面形状について説明する。まず、半導体レーザ 1 1 の出射領域 1 2 のスロー軸方向の長さをDslow\_LD、ファスト軸方向の長さをDfast\_LDとする。また、半導体レーザ 1 1 の出射光の広がり角を、スロー軸方向で $\theta$  slow\_LD、ファスト軸方向で $\theta$  fast\_LDとする。

[0029]

さらに、光ファイバ15の入射端面部16上におけるビーム径を、スロー軸方向で $Dslow_FB$ 、ファスト軸方向で $Dfast_FB$ とし、広がり角をスロー軸方向で $\theta$ s $low_FB$ 、ファスト軸方向で $\theta$ fast $_FB$ とする。

[0030]

すると、正弦条件により、

[0031]

光ファイバ15は、受光角が光軸対称であるため、光ファイバ15に入射する 時点で、半導体レーザ11から出射した光の広がり角が光軸対称になっているこ とが望ましいことになる。

[0032]

入射端面部16で、スロー軸方向の広がり角とファスト軸方向の広がり角とが 等しくなるように、シリンドリカルレンズ13,14を用いて広がり角を変換す ると、 $\theta$  slow\_FB= $\theta$  fast\_FBより、入射端面部 1 6 でのビーム径のスロー軸方向とファスト軸方向との比は、

Dslow\_FB/Dfast\_FB

= [Dslow\_LD · sin ( $\theta$  slow\_LD)] / [Dfast\_LD · sin ( $\theta$  fast\_LD)] ... (3)

となり、この比に応じてコア断面における楕円の長軸短軸比を設定することが望ましいこととなる。

[0033]

半導体レーザ11の出射光をなるべく高い光密度で入射するためには、

 $\theta$  slow\_\_FB=  $\theta$  fast\_\_FB=光ファイバの最大受光角 として、(1)、(2)式よりコア断面の断面形状を決定すれば良い。

[0034]

光ファイバ15は、その入射端面部16から奥方向に向けて、コア断面が楕円から正円に連続的に変化している。このため、入射端面部16に入射した光は、 光ファイバ15内を伝播するにしたがって、楕円の長軸方向では正円に近づくに つれて径が小さくなるため、広がり角が大きくなる傾向があり、楕円の短軸方向 では正円に近づくにつれて径が大きくなるため、広がり角が小さくなる傾向があ る。

[0035]

しかしながら、光ファイバ15は、コアの側面が楕円の長軸短軸に対して斜め となっている。このため、コア内で光が複数回反射することによって、前記した 広がり角が大きくなる傾向と小さくなる傾向とが相殺され、楕円と正円との面積 が一定なら広がり角は変化しない。

[0036]

これにより、光の広がり角が変化しないまま楕円から正円にビーム径が変換されることが可能となる。この効果により、半導体レーザ11から出射した光を高効率及び高光密度の状態で、コア断面形状が正円の光ファイバ15に入射することが可能となる。

[0037]

図2は、この発明の第2の実施の形態を示している。図2において、図1と同一部分には同一符号を付して説明すると、この第2の実施の形態では、第1の実施の形態で説明した半導体レーザ装置を、光ファイバレーザの励起光入力に用いている。

## [0038]

図2において、符号17はコア内にレーザ活性物質が添加された光ファイバ、18は半導体レーザ11から出射する光(励起光)を透過し、光ファイバ17で発生するレーザ光を反射する反射素子、19は光ファイバ17で発生するレーザ光を一部反射する反射素子である。図2における(a)~(d)は、それぞれ、光ファイバ15,17の各箇所における断面形状を示している。

## [0039]

具体的に言えば、例えば、半導体レーザ11の波長は $830\sim850$ nm、光ファイバ17のコア内のレーザ活性物質は $Pr^{3+}/Yb^{3+}$ 、反射素子18は $830\sim850$ nmの光を全透過し635nmの光を全反射、反射素子19は635nmの光を一部反射する。

## [0040]

半導体レーザ11から出射された830から850nmの励起光は、シリンドリカルレンズ13, 14、光ファイバ15を介して光ファイバ17に入射する。この励起光は、光ファイバ17内の $Pr^{3+}/Yb^{3+}$ に吸収され、635nmの光を発生する。

#### [0041]

発生した635nmの光は、反射素子18と19との間に形成される共振器により、635nmのレーザ光に生成され、反射素子19側から出力されることになる。光ファイバレーザの励起光には、高出力及び高光密度が必要となり、第1の実施の形態の半導体レーザ装置を利用することで光ファイバレーザを実現することが可能となる。

#### [0042]

図3は、この発明の第3の実施の形態を示している。図3において、図2と同一部分には同一符号を付して示している。第2の実施の形態との違いは、入射端

面部16を楕円に加工した光ファイバ15のコア径と、レーザ活性物質を添加した光ファイバ17のコア径とが違う点にある。

[0043]

光ファイバ15に関しては、楕円加工の容易さによってコア径を決定することが望ましい。例えば、光ファイバ15にプラスチックファイバを用いれば、プラスチックファイバの端面を加熱した状態で圧力を加えることにより、偏平化(楕円化)することが可能になる。

[0044]

プラスチックファイバのコア径は、一般に $100\mu$ m以上である。一方、レーザ活性物質が添加された光ファイバ17のコア径は、数 $100\mu$ m〜数 $\mu$ mであり、用途により様々である。

[0045]

このため、両者のコア径が一致するとは限らない。そこで、この第3の実施の 形態では、光ファイバ15で楕円から正円へのビーム形状の変換を行なった後、 レンズ20を用いて光ファイバ17のコア径への変換を行なっている。

[0046]

ここで、光ファイバ15の入射端面部16のコアの楕円形状は、長軸短軸比が上記(3)式にしたがうようにするとともに、半導体レーザ11の出射領域12の形状と、光ファイバ15の入射端面部16のコア楕円形状とが共役関係となるように、シリンドリカルレンズ13,14を設定する。

[0047]

光ファイバレーザの動作としては、第2の実施の形態と同様なので省略する。 なお、コア径を変換するための変換手段としては、レンズ20に限らず、コア径 が連続的に変化するテーパファイバ等、他の光学手段を用いても構わない。

[0048]

図4は、この発明の第4の実施の形態を示している。図4において、図2と同一部分には同一符号を付している。第2の実施の形態との違いは、複数(図4では4つ)の半導体レーザ装置を並列に配置し、各光ファイバ15を束ねた後、レーザ活性物質を添加光した光ファイバ17に光を入射する点にある。

[0049]

第2の実施の形態で示した光ファイバレーザで得られるレーザ光の出力以上の 出力が必要となる場合、第2の実施の形態の構成をそのまま複数個配置すると光 ファイバ17、反射素子18,19が複数本必要となる。

[0050]

また、光ファイバレーザの出力を別の光ファイバに光接続する場合、接続する 光ファイバも複数本必要となりコストが増加する。このため、複数の光ファイバ 15を束ねた状態で、光ファイバ17に光接続しコストを低下している。

[0051]

図5(a)~(d)は、それぞれ、図4の(a)部分の断面図を示している。 光密度が高い状態で光ファイバ15を束ねるためには、光ファイバ15はクラッドの厚みが薄いものを使用することが望ましい。

[0052]

また、図5(a)に示すように、単に束ねるだけでなく、同図(b)~(d)に示すようにコアが密着し、かつ、光ファイバ17のコア断面形状と同形状となるように端面部を加工することが望ましい。

[0053]

密着した状態での各光ファイバ15の断面形状は、正円から図5(b)~(d)に示す形状に面積一定のまま連続的に変化していく必要がある。しかしながら、図5(b)及び(c)に示すように整形された状態でなく、同図(d)に示すように外形のみが整形されていれば良いため加工が容易となる。

[0054]

加工部分と未加工部分とでコア断面積一定のまま連続的に変化しているため、 光の広がり角は変化せず、高効率及び高光密度を保ったまま光ファイバ17への 光接続が可能となる。

[0055]

図6は、この発明の第5の実施の形態を示している。図6において、図3と同一部分には同一符号を付している。この第5の実施の形態は、第3及び第4の実施の形態を組み合わせたものであり、束ねた光ファイバ15のコア径と、レーザ

活性物質を添加した光ファイバ17のコア径との違いを、レンズ20で補正している。

#### [0056]

なお、上記した各実施の形態においては、光ファイバ15の入射端面部16を 加工した際、加工部分と未加工部分とで面積が一定になるように説明した。肝要 な点は、ビーム形状を変換していることである。

### [0057]

すなわち、面積が一定の場合には、加工部分と未加工部分とで広がり角は一定であるが、面積が一定でない場合には、加工部分と未加工部分との面積比に反比例して広がり角が変化することになる。このため、広がり角を変化させたい、あるいは面積も変化させたい場合には、加工部分と未加工部分とで面積が異なるようにしても良い。

#### [0058]

図7は、この発明の第6の実施の形態を示す映像表示装置の構成図である。第6の実施の形態では、第2~第5の実施の形態の光ファイバレーザを投射型映像表示装置の光源として使用している。

#### [0059]

図7において、符号21,22,23は、それぞれ、光ファイバレーザを示している。この光ファイバレーザ21~23では、波長のアップコンバージョンにより赤、緑、青のレーザ光が得られるように、光ファイバ17に添加するレーザ活性物質や、半導体レーザ11の発振波長等がそれぞれ設定されている。

### [0060]

また、符号24,25,26は、それぞれ、光ファイバレーザ21,22,23から発生されたレーザ光を出力する光ファイバ、27はレンズ、28は映像入力端子、29は液晶駆動部、30は液晶パネル、31は投射レンズ、32はスクリーンである。

#### [0061]

映像表示装置の動作について説明する。すなわち、光ファイバ24~26の端面から出射された光は、レンズ27にて平行光となり、液晶パネル30に入射さ

れる。

## [0062]

一方、映像信号は、映像入力端子28から入力され、液晶駆動部29が映像信号に基づいて液晶パネル30を駆動する。これにより、液晶パネル30に入射され光は、映像信号に沿った空間変調が施される。

## [0063]

空間変調された光は、投射レンズ31を介してスクリーン32に結像される。 投射形映像表示装置の光源には、数W程度の赤、緑、青の光が必要だが、第2~ 第5の実施の形態で示した光ファイバレーザを用いることにより、低コストで実 現できる。

#### [0064]

以上に述べたように、光ファイバ15の端面部分のみを連続的に変形させることで任意にビーム形状を変換する。加工部分と未加工部分とが面積一定の場合には、両者で光の広がり角は変化しない。

## [0065]

この特徴を利用して、光ファイバ15の入射端面部16を楕円化すれば、半導体レーザ11から出射される光を、高効率及び高光密度で光ファイバ15に入射させることが可能となる。また、その出力を通常のコア断面が円形の光ファイバに光接続することが可能となる。

#### [0066]

さらに、複数の光ファイバ15を束ねて、1本の光ファイバ17に結合する際に、複数本束ねた光ファイバ15の外形断面と、1本の光ファイバ17の断面とが同形状になるように、複数本の光ファイバ15の端面部分を加工することで、両者の光接続が高効率及び高光密度で実現できる。

#### [0067]

また、この利点を用いて半導体レーザ11を励起光に用いた光ファイバレーザを構成し、光ファイバレーザを用いた波長のアップコンバージョンにより高出力の赤、緑、青を発生させ、投射型映像表示装置の光源として利用することが可能となる。

[0068]

なお、この発明は上記した各実施の形態に限定されるものではなく、この外その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。

[0069]

【発明の効果】

以上詳述したようにこの発明によれば、簡易な構成で半導体レーザからの出射 光を高効率及び高光密度で光ファイバに容易に入射させることを可能とした半導 体レーザ装置、半導体レーザの制御方法を提供することができる。また、この発 明によれば、上記した半導体レーザ装置を用いた映像表示装置を提供することが できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の第1の実施の形態を説明するために示す図。

【図2】

この発明の第2の実施の形態を説明するために示す図。

【図3】

この発明の第3の実施の形態を説明するために示す図。

【図4】

この発明の第4の実施の形態を説明するために示す図。

【図5】

同第4の実施の形態における要部を詳細に説明するために示す図。

【図6】

この発明の第5の実施の形態を説明するために示す図。

【図7】

この発明の第6の実施の形態を説明するために示す図。

【符号の説明】

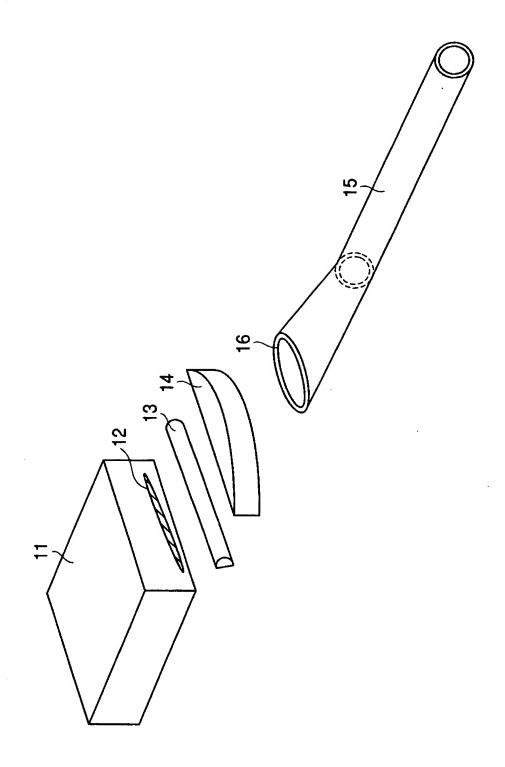
- 11…半導体レーザ、
- 12…出射領域、
- 13, 14…シリンドリカルレンズ、

- 15…光ファイバ、
- 16…入射端面部、
- 17…光ファイバ、
- 18,19…反射素子、
- 20…レンズ、
- 21~23…光ファイバレーザ、
- 24~26…光ファイバ、
- 27…レンズ、
- 28…映像入力端子、
- 29…液晶駆動部、
- 30…液晶パネル、
- 31…投射レンズ、
- 32…スクリーン。

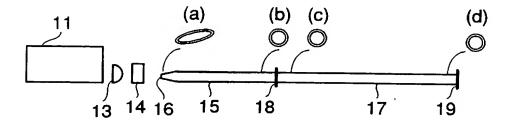
【書類名】

図面

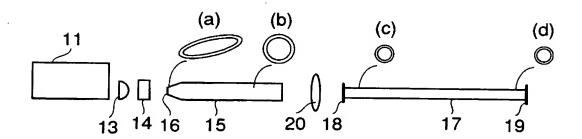
【図1】



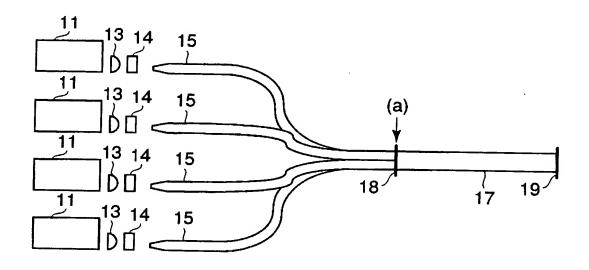
【図2】



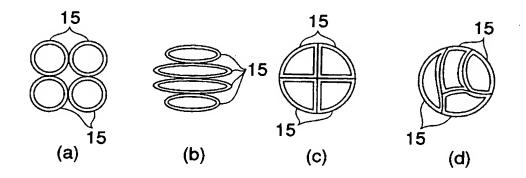
【図3】



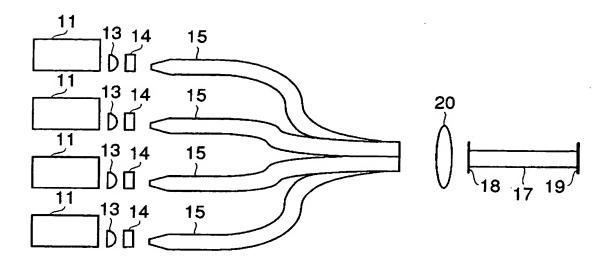
【図4】



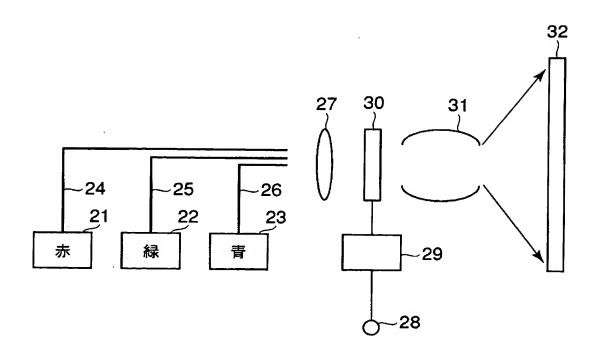
【図5】



【図6】



【図7】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】この発明は、簡易な構成で半導体レーザからの出射光を高効率及び高光密度で光ファイバに容易に入射させることを可能とした半導体レーザ装置、半導体レーザの制御方法と、この半導体レーザ装置を用いた映像表示装置を提供することを目的としている。

【解決手段】半導体レーザ11から出射される光をシリンドリカルレンズ13,14により平行光に変換する。そして、このシリンドリカルレンズ13,14を通過した光を、途中の所定位置から入射端面部16に向けて、断面積を一定としたままで入射端面部16におけるコア形状が楕円形となるように連続的に変化させた光ファイバ15に入射させる。

【選択図】 図1



# 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日

2001年 7月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名

株式会社東芝